

Základy technologie

fotonických vlnodných struktur

UFE

Některé významnější technologie

Iontová výměna ve skleněných podložkách (ion exchange)

Pasivní, případně aktivní struktury (dopované Er^{3+})

Silica on silicon ($\text{Si}/\text{SiO}_2/\text{SiO}_2:\text{Ge,P}/\text{SiO}_2$)

chemické depozice, hydrolýza plamenem (IO „vlákno“)

Měrný útlum řádu 0.001 dB/cm

Pasivní součástky, termooptické, aktivní (dopované Er^{3+})

Polymery

Termooptické (elektrooptické?) modulátory a přepínače

Ti:LiNbO₃, APE LiNbO₃ (annealed proton exchange)

Elektrooptické, akustooptické, aktivní (dopované Er^{3+}),

nelineární optické prvky (kaskádní procesy χ^2 : χ^2)

Polovodiče III-V ($\text{InP}/\text{Ga}_x\text{In}_y\text{As}_{1-x-y}$, $\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$)

MOCVD, MBE, CBE

Lasery, polovodičové zesilovače, elektroabsorpční modulátory, spektrální de/multiplexory, detektory,...

Silicon on Insulator ($\text{Si}/\text{SiO}_2/\text{Si}$)

(„wafer bonding“, extrémní kontrast indexu lomu 3,5 : 1, extrémní hustota součástek)

UFE

Příprava masek na elektronovém litografu

1. Modelování a návrh struktury vlnodů a elektrod
2. Příprava dat pro elektronový litograf (digitalizace?)
3. Skleněná (křemenná) podložka s cca 50-100 nm Cr („matný chrom“)
4. Depozice elektronového rezistu odstředivkou (roztok PMMA)
5. Expozice rezistu elektronovým svazkem
6. „Vyvolání“ fotorezistu (odstranění exponovaných míst)
7. Iontové leptání chromové vrstvy

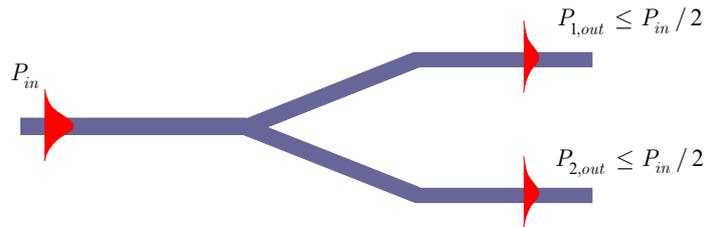
UFE

Pasivní fotonické vlnodné struktury

UFE

Vlnodné rozvětvení 1×2

1. Jednovidové rozvětvení buzené do společné větve



Výkon se dělí rovnoměrně do obou výstupních větví z důvodů symetrie

UFE

Symetrické rozvětvení buzené v opačném směru

2. Současné buzení do obou větví se vzájemným fázovým posuvem $\Delta\varphi$

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_s + e_a),$$

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_s - e_a)$$

$$E_{out} \cong e_1 e^{i\Delta\varphi/2} + e_2 e^{-i\Delta\varphi/2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_s + e_a) e^{i\Delta\varphi/2} + \frac{1}{\sqrt{2}}(e_s - e_a) e^{-i\Delta\varphi/2} =$$

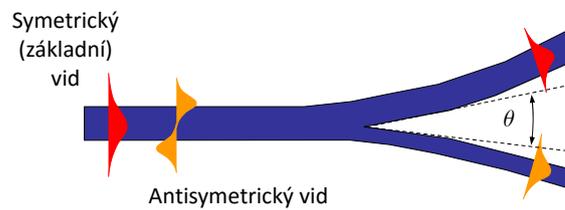
$$= \sqrt{2} e_s \cos \frac{\Delta\varphi}{2} + \sqrt{2} i e_a \sin \frac{\Delta\varphi}{2} \rightarrow (e_1 + e_2) \cos \frac{\Delta\varphi}{2} = E_{in} \cos \frac{\Delta\varphi}{2}$$

$$P_{out} \leq P_{in} \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2} = P_{in} \cos^2 \left(\frac{\pi u}{2 U_{\pi}} \right)$$

Relativní změnou fáze vidů ve vstupní větvi je možno měnit výstupní výkon

UFE

Asymetrické vlnovodné rozvětvení jako oddělovač vidů

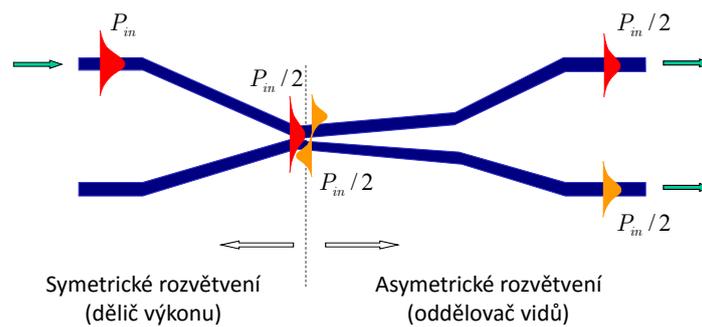


$$\frac{\Delta N_{eff}}{\sqrt{n_s^2 - N_{eff}^2} \theta} \begin{cases} > 1, & \Rightarrow \text{asymetrické Y, oddělovač vidů} \\ < 0.1, & \Rightarrow \text{symetrické Y, dělič výkonu} \end{cases}$$

Pokud je výstupní úhel θ velmi malý ($\theta < 0,2^\circ$) a výstupní větve asymetrické, chová se rozvětvení Y jako **oddělovač vidů**, nikoli jako dělič výkonu

UFE

Spektrálně nezávislá odbočnice 2x2

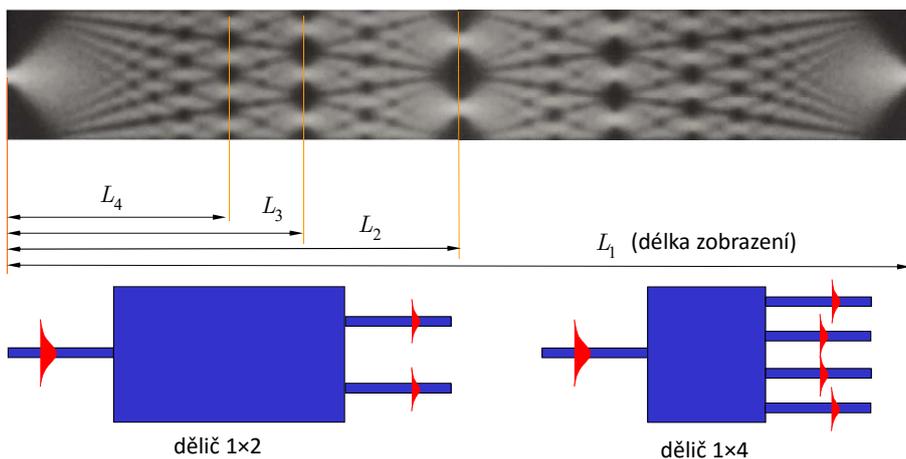


Odbočnice může pracovat v celém intervalu 1,25 – 1,6 μm ; omezení je dáno **oblastí jednovidového režimu** vlnovodů

UFE

Děliče s mnohovidovou interferencí

Princip: Interference vidů v **mnohovidovém** planárním vlnovodu (~1978)



UFE

Úprava pro zmenšení fázové chyby (snížení počtu potřebných vidů)

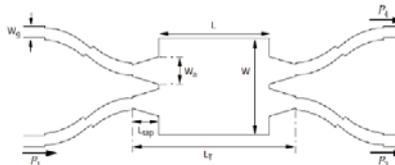
původní tvar



modifikovaný tvar



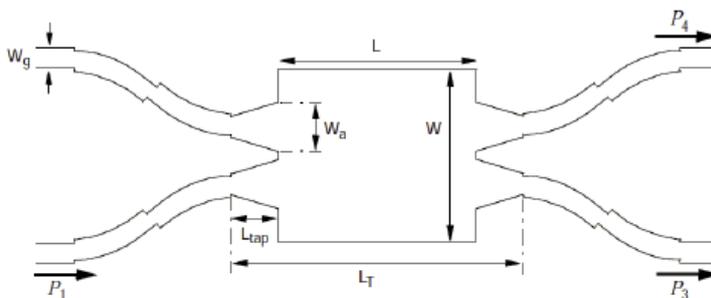
struktura děliče 2×2 včetně vstupních a výstupních vlnovodů



M.T.Hill, J. Lightwave Technol. **21**, 2305-2313, 2003

UFE

Vazební člen 2x2 s úpravou pro zmenšení fázové chyby (snížení počtu potřebných vidů) a redukcí ztrát v ohybech

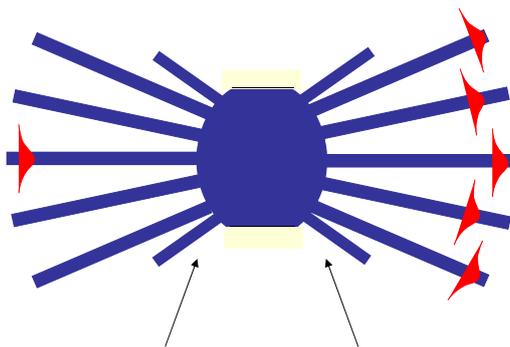


M.T.Hill, J. Lightwave Technol. 21, 2305-2313, 2003

struktura děliče 2x2 včetně
vstupních a výstupních vlnovodů

UFE

Hvězdicový difrakční vazební člen MxN



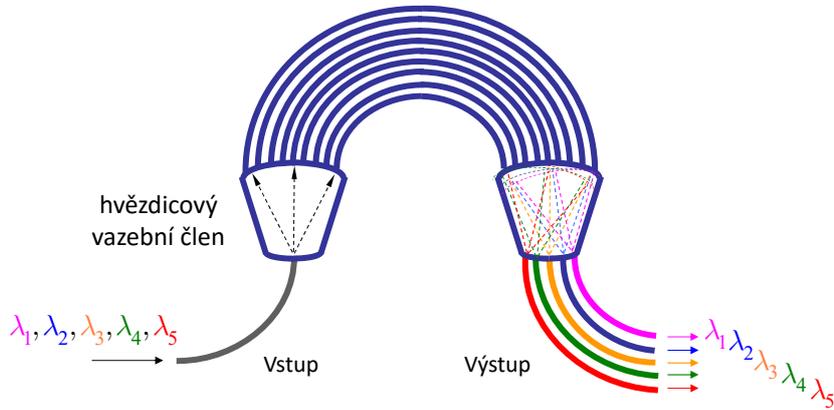
„Jalové“ vlnovody pro zlepšení rovnoměrnosti rozdělení výkonu

Umožňuje rovnoměrně navázat záření do velkého počtu
(až několika desítek) vlnovodů

UFE

Spektrální demultiplexor s fázovanou řadou vlnovodů („Phasar“, AWG – arrayed waveguide grating demux)

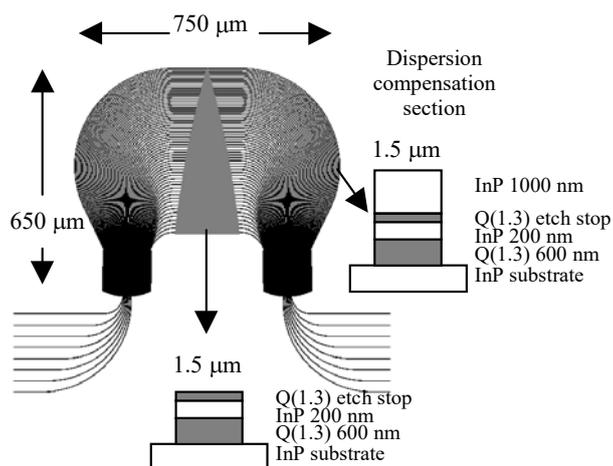
Fázovaná řada (několika desítek) vlnovodů



M. K. Smit, 1987; dnes asi nejoblíbenější součástka

UFE

Příklad provedení integrovaně-optického AWG demultiplexoru na bázi InP

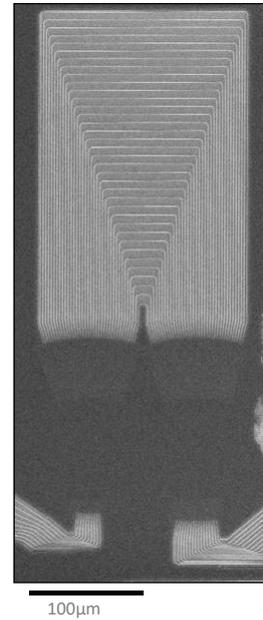
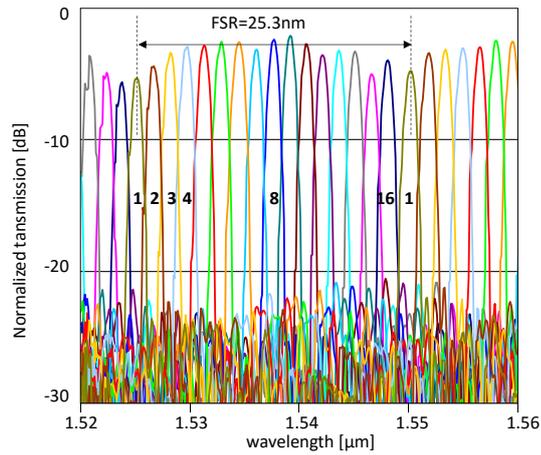


$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{f} \Delta f = \frac{\lambda^2}{c} \Delta f; \text{ pro } \lambda = 1550 \text{ nm a } \Delta f = 100 \text{ GHz je } \Delta\lambda = 0.8 \text{ nm}$$

UFE

AWG

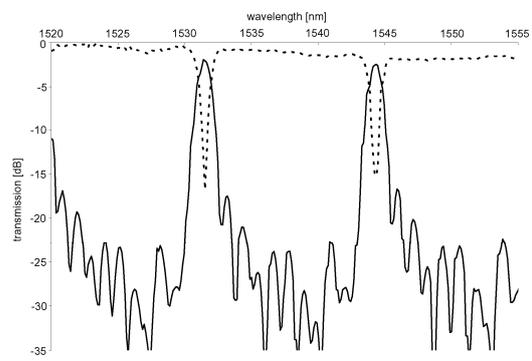
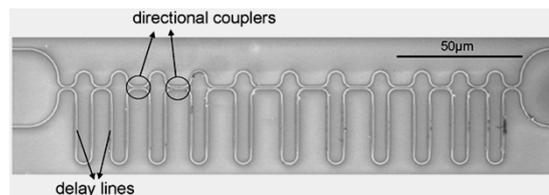
- 16-channel AWG, 200GHz
- 200 μm x 500 μm area
 - -3dB insertion loss
 - -15dB to -20dB crosstalk



UFE

Machūv-Zehnderūv filtr 11. řádu

- Channel drop, 1 out of 8
- $\Delta f_{\text{ch}} = 200\text{GHz}$
- 11th order filter
- -15dB crosstalk



UFE

Dynamické a nelineární fotonické vlnovodné prvky

UFE

Poruchová metoda výpočtu konstanty šíření „slabě modifikovaného“ vlnovodu

Zjednodušená rovnice „vázaných vln zanedbávající zpětné vlny:

$$\frac{da_\mu(z)}{dz} = i\beta_\mu a_\mu(z) + i\sum_\nu K_{\mu\nu}^{++}(z)a_\nu(z).$$

Pro slabou *homogenní* poruchu (nezávislou na z) přibližně platí

$$\frac{da_\mu(z)}{dz} \approx i\beta_\mu a_\mu(z) + iK_{\mu\mu}^{++}a_\mu(z), \quad \text{neboli} \quad \frac{da_\mu(z)}{dz} \approx i(\beta_\mu + K_{\mu\mu}^{++})a_\mu(z), \quad \text{a}$$

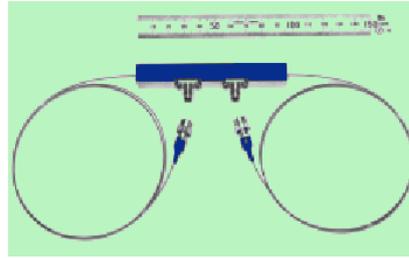
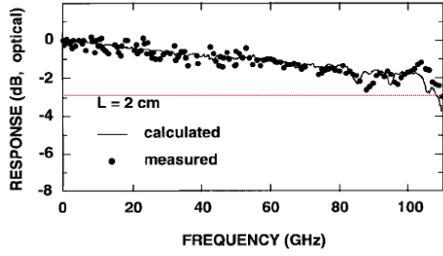
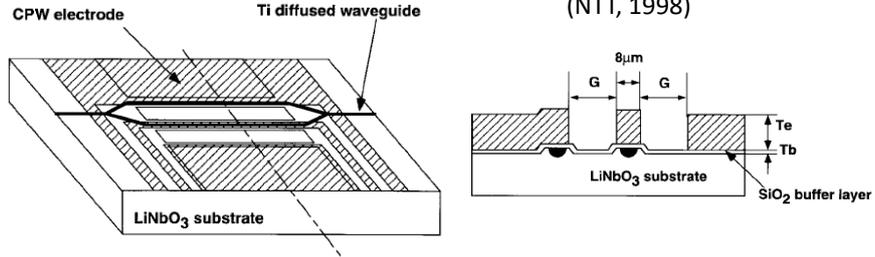
$$a_\mu(z_0 + \Delta z) \approx \exp\left[i(\beta_\mu + K_{\mu\mu}^{++})\Delta z\right]a_\mu(z_0).$$

„Porucha“ tedy (v prvním přiblížení) způsobí změnu konstanty šíření o hodnotu

$$\Delta\beta = \frac{\omega\varepsilon_0}{4} \frac{|\beta_\mu|}{\beta_\mu} \iint_S [\varepsilon(x, y) - \varepsilon^{(0)}(x, y)] \left(\left| \mathbf{e}_{\mu\perp}^*(x, y) \right|^2 + \frac{\varepsilon^{(0)}(x, y)}{\varepsilon(x, y)} \left| e_{\mu z} \right|^2 \right) dx dy.$$

UFE

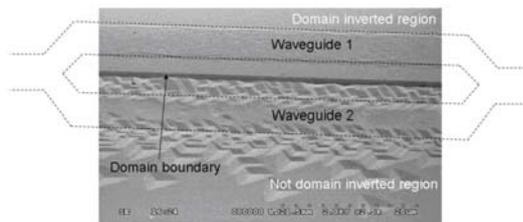
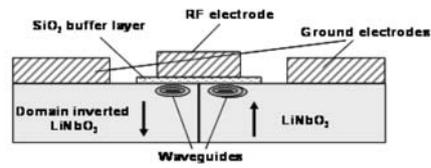
100 GHz LiNbO_3 modulátor s ovládacím napětím 5,1 V



UFE

Modulátor využívající inverzi domén v LiNbO_3

Zjednodušení elektroodové struktury:



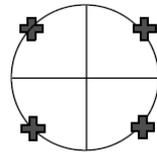
Valerio Pruneri et al.,
Avanex Corporation, Italy
ICFO, Spain
ICREA, Spain, 2007

UFE

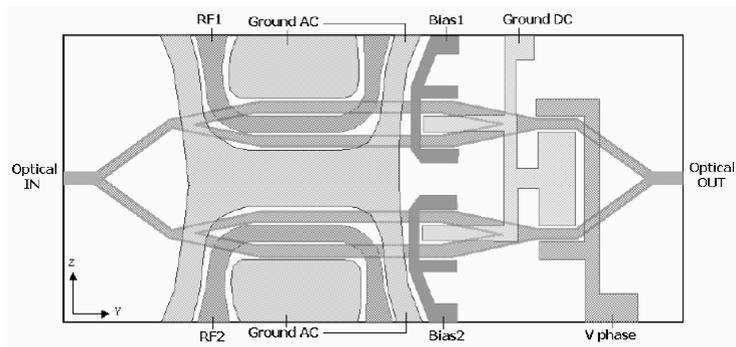
Modulátor pro kvadrurní fázovou modulaci (QPSK)

Imaginary axis

Modulační formát přenášející 2 bity/symbol

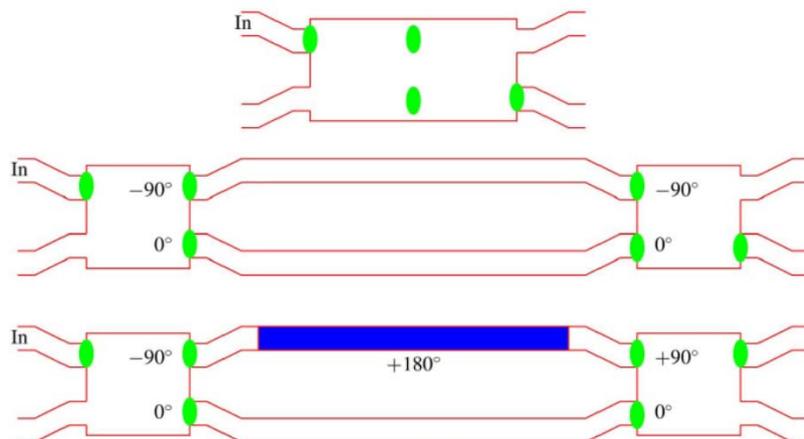


Realizace v LiNbO_3



UFE

Machův-Zehnderův interferometrický přepínač/modulátor v polovodičovém materiálu (InP/InGaAsP), elektrorefraktivní modulace

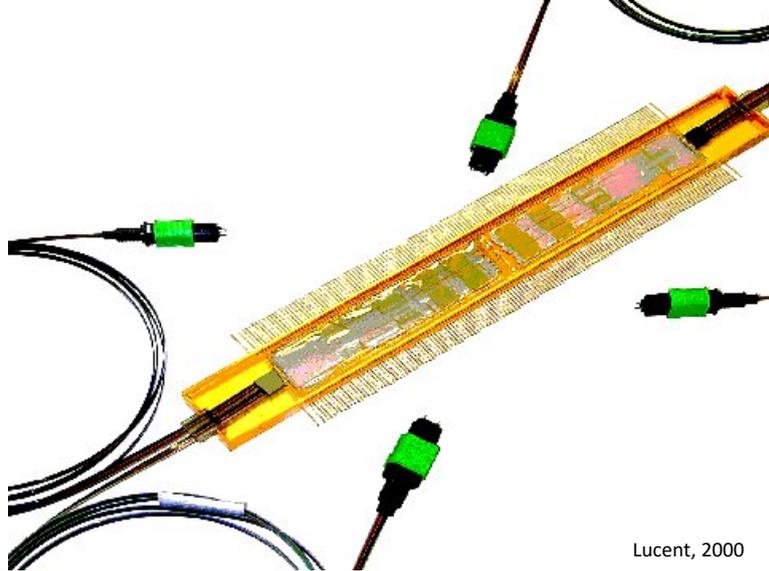


 COBRA TU/e

UFE

Elektrooptický přepínač 16×16 v Ti:LiNbO₃ (2×20×5 mm)

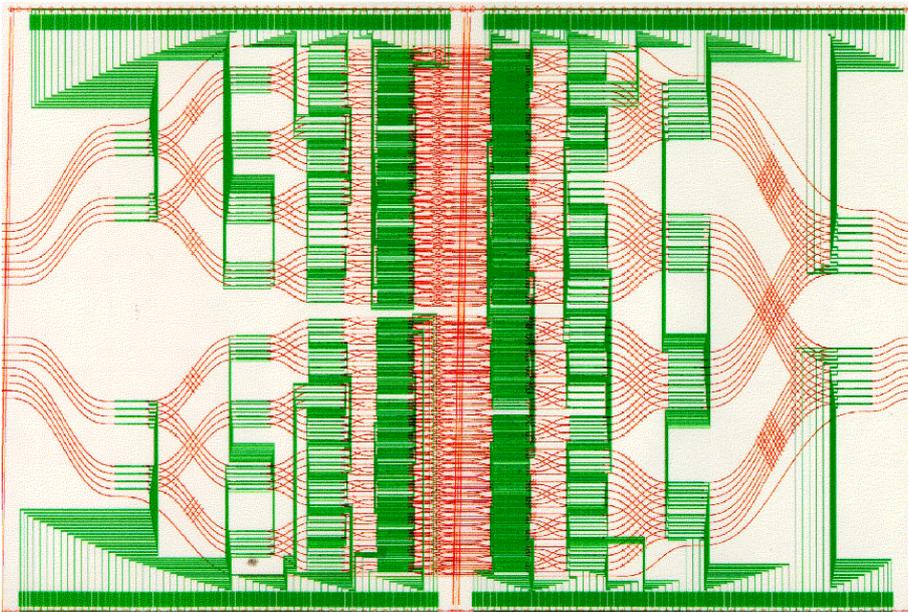
„Neblokující“ architektura, 480 DOS přepínačů. $U = \pm 45$ V, IL < 15 dB,
 $\tau \cong 5$ ns, kompenzace PMD křemennou $\lambda/2$ destičkou (PMD < 1 ps)



Lucent, 2000

UFE

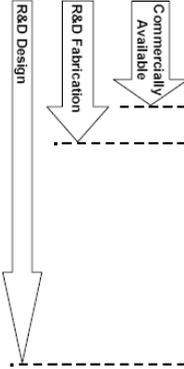
„Layout“ optických vlnovodů a elektrodové struktury přepínače



UFE

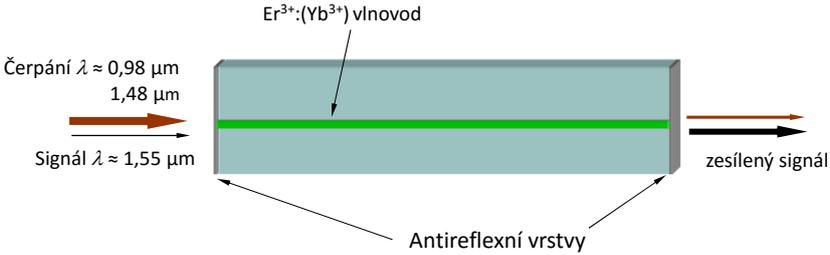
Počet přepínačů 1x2 („DOS“) potřebný pro realizaci
přepínací matice N x N s „neblokující architekturou“

N	Number of 1x2's
2	4
4	24
8	112
16	480
32	1984
64	8064
128	32,512
256	130,560
512	523,264
1024	2,095,104



UFE

Vlnovodné optické zesilovače a lasery (EDWA, EDWL)



Vlnovody z různých materiálů: (fosfátové) sklo, Al₂O₃, LiNbO₃, ...
zesílení ≈ 10 dB

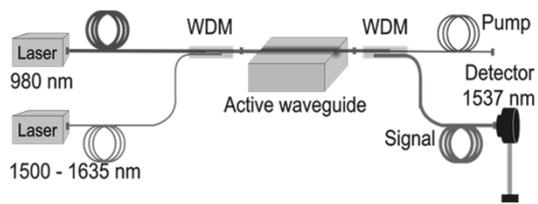
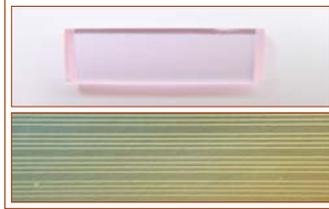
Výhody: malé rozměry, možnost současného zesilování signálů
na různých „nosných“ vlnových délkách
možnost integrace s pasivními součástkami na jednom čipu
("zero-dB splitter")

Nevýhody: malá délka -> vysoká koncentrace dopantů, **malé zesílení**

UFE

Vlnodný optický zesilovač dopovaný erbiem

Substrátové sklo a iontová výměna: VŠCHT, litografie a charakterizace: ÚFE

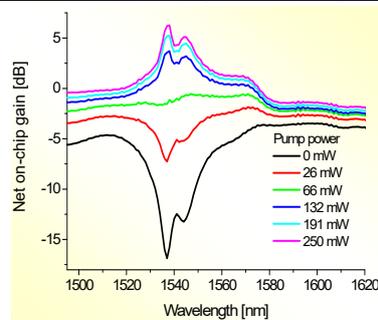


ÚFE

Vlnodný optický zesilovač dopovaný erbiem

Substrátové sklo a iontová výměna: VŠCHT, litografie a charakterizace: ÚFE

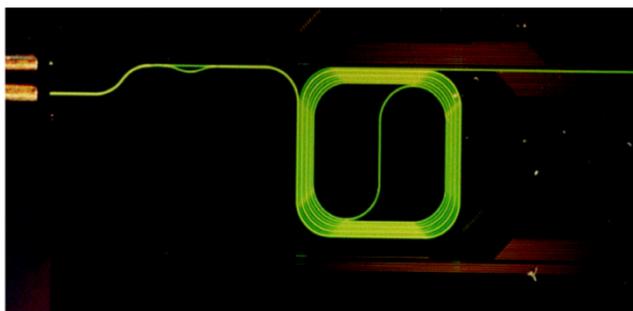
Waveguide parameters	K ⁺	Ag ⁺
Mode-field dimensions	9.6×12.9 μm	6.1×7.0 μm
Mode-field dimensions @ 980 nm	6.9×10.5 μm	3.2×4.8 μm
Scattering loss @ 1550 nm	0.18 dB/cm	0.85 dB/cm



ÚFE

Vlnodný zesilovač $\text{Al}_2\text{O}_3: \text{Er}^{3+}$ na Si/SiO_2 podložce

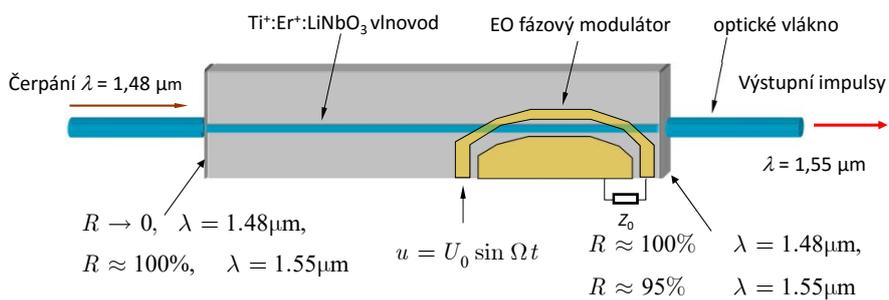
spirála $1 \times 1 \text{ mm}^2$
zisk 2,3 dB na $\lambda = 1,55 \mu\text{m}$ při čerpání 10 mW na $1,48 \mu\text{m}$



M.K. Smit et al. (TUD); Appl. Phys. Lett. **68**, 1888 (1996)

UFE

Vlnodný $\text{Ti}:\text{Er}:\text{LiNbO}_3$ laser s integrovaným elektrooptickým modulátorem pro synchronizaci vidů



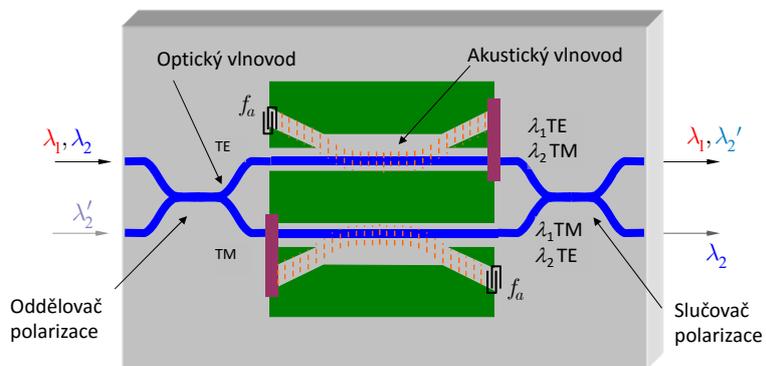
Ultrakrátké pulsy ($\leq 5 \text{ ps}$), opakovací frekvence $\approx 20 \text{ GHz}$

(Univerzita Paderborn, D, 1997-2000)

UFE

Polarizačně nezávislý akustoopticky laditelný začleňovací/vydělovací demultiplexor v LiNbO₃

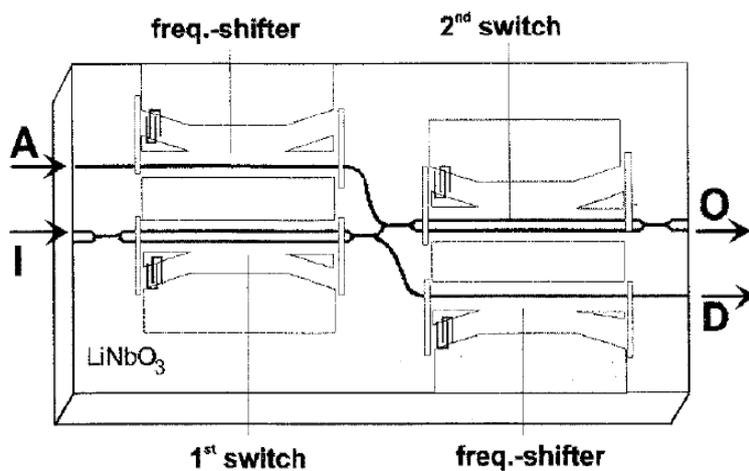
Princip: kolineární AO TE-TM konverze



Střední vlnová délka $\lambda_c = 1,55 \mu\text{m}$,
vzdálenost kanálů $< 1 \text{ nm}$, přeladitelnost $\Delta\lambda \approx 70 \text{ nm}$

UFE

Add-drop multiplexer s kaskádním řazením filtrů a kompenzací frekvenčního posuvu



(Univerzita Paderborn 1997-2000)

UFE

Konec části 3

UFE